

# 2Т831А - 2Т831Г

аА0.339.140 ТУ

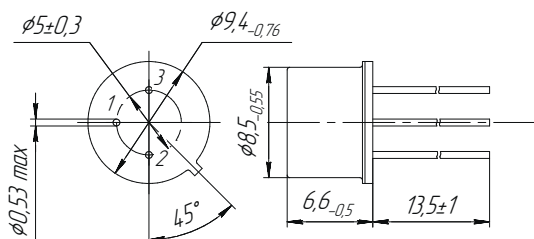
аналог 2N4300

Эпитаксиально - планарные транзисторы



Усилители мощности,  
вторичные источники питания,  
преобразователи,  
специальная техника.  
 $T_{\text{экспл}}: -60^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$

- 1 — база
- 2 — эмиттер
- 3 — коллектор



Металлостеклянный корпус КТ-2-7 (ТО-39)

| № п/п | Наименование параметра, единица измерения (режим измерения при $T_{\text{окр. ср.}} = +25^{\circ}\text{C}$ )                                             | Условное обозначение | Значение параметров |          |          |          |          |          |          |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|       |                                                                                                                                                          |                      | 2Т831А              |          | 2Т831Б   |          | 2Т831В   |          | 2Т831Г   |          |
|       |                                                                                                                                                          |                      | не менее            | не более | не менее | не более | не менее | не более | не менее | не более |
| 1.    | Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В                                                                                           | $U_{\text{КБ max}}$  | 35                  | -        | 60       | -        | 80       | -        | 100      | -        |
| 2.    | Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор – эмиттер, В ( $R_{\text{БЭ}} \leq 1 \text{ кОм}$ )                                               | $U_{\text{КЭ max}}$  | 30                  | -        | 50       | -        | 70       | -        | 90       | -        |
| 3.    | Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер – база, В                                                                                           | $U_{\text{ЭБ max}}$  | 5                   | -        | 5        | -        | 5        | -        | 5        | -        |
| 4.    | Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А                                                                                                      | $I_{\text{К max}}$   | -                   | 2        | -        | 2        | -        | 2        | -        | 2        |
| 5.    | Статический коэффициент передачи тока, ( $U_{\text{КБ}} = 1 \text{ В}$ , $I_{\text{Э}} = 1 \text{ А}$ )                                                  | $h_{21Э}$            | 25                  | 200      | 25       | 200      | 25       | 200      | 20       | 150      |
| 6.    | Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ( $I_{\text{К}} = 1 \text{ А}$ , $I_{\text{Б}} = 0,1 \text{ А}$ )                                              | $U_{\text{КЭ нас}}$  | -                   | 0,6      | -        | 0,6      | -        | 0,6      | -        | 0,6      |
| 7.    | Граничная частота коэффициента передачи тока, МГц ( $U_{\text{КЭ}} = 5 \text{ В}$ , $I_{\text{Э}} = 0,05 \text{ А}$ , $f_{\text{изм}} = 1 \text{ МГц}$ ) | $f_{\text{гр}}$      | 4                   | 50       | 4        | 50       | 4        | 50       | 4        | 50       |
| 8.    | Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_{\text{К}} = +25^{\circ}\text{C}$ , Вт                                         | $P_{\text{К max}}$   | -                   | 5        | -        | 5        | -        | 5        | -        | 5        |

Возможна поставка в бескорпусном исполнении разделенными или не разделенными на кристаллы

1. 1. 2. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ N-P-N ТИПА